

INSTRUMENTATION

# CATALOG



**半導體目錄**  
**2018**

## 傅立葉轉換紅外光譜儀(FTIR) Nanometrics QS-1200

- 可測Si/SiC/GaN多種同質結構外延層膜厚
- 矽材料中的氧、碳含量
- BPSG中的硼、磷含量
- SiN鈍化層中的氮含量
- FSG中的氟含量
- 可做2D/3D的Mapping
- 可對形狀不規則的矽片進行量測
- D2W特殊型號可測擴散層結深厚度

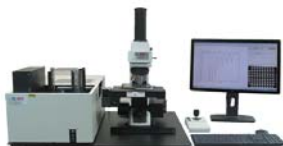


## 半導體膜厚測量儀 Nanometrics Nanospec II

- 薄膜厚度測量精度可達1Å以下
- 支持75~300mm晶圓測量
- 支援厚膜測量到150μm
- 可選配UV光源，測量50Å薄膜
- 可選配Robot系統實現全自動測量
- 針對AlGaIn多層外延厚度測量
- 可匹配並替代XRD測試功能

## 先進封裝TSV器件測量系統 FilmTek 2000/2000MTSV

- 可搭配自動測試台，提供全片mapping功能
- 可提供小光斑到5μm
- 可增加備偏儀組件
- 有全自動機型，適用於8"12"晶圓，可測TSV，臨界尺寸



## 薄膜應力測量系統 MicroSense UMA-C200-STR

- 與市場主流5400/5500系統測量資料一致
- 支持6, 8 inch晶圓, 2mm留邊
- 支持Open Cassette, SMIF
- 整片掃描超過120,000點
- 精確的曲率半徑計算
- 可支援半自動及全自動機型



## 全自動光學檢測系統 Nanotronics nSpec

- 高端全自動微觀檢測系統，可應用於材料科學與生命科學
- 可適用透明及半透明wafer缺陷檢測
- 超高解析度亞微米級圖像顯示
- 50~300mm晶圓表面缺陷檢測
- 結合AFM系統，可檢測原子等級缺陷



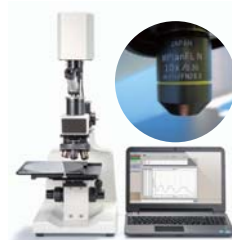
## 矽棒少子壽命測試儀 Napson HF-100DCA

- 行業標準的矽錠少子壽命測試系統
- 符合日本工業規範的直接電流陽極氧化測試方法
- 通過數位示波器採樣及軟體資料處理



## 半導體膜厚測量儀 Tohospec 3100/Tohospec 3100T

- 測量半導體制程中的薄膜厚度
- 搭配不同倍率顯微鏡，可看到不同解析度的結構，並可調節測試光斑大小
- 厚度測量範圍10nm~70μm
- 用於半導體、平板顯示、LED行業等行業，評估膜層品質



## 微光斑光譜反射膜厚測量儀 FilmTek 4000 PAR-SE

- 使用具有旋轉補償器的分光光譜橢圓偏光法，295~1700nm
- 多角度，偏置分光光譜反射，190~1700nm
- 獨立測試膜厚和折射率
- 多角度差分偏置技術，包含SCI專利差分能量譜強度技術
- 測試超薄膜(原生氧化物)薄膜重複性可達0.03Å)
- 專利拋物線透鏡聚焦技術，50μm\*50μm微光斑大小
- 帶有wafer handler的全自動系統
- Pattern Recognition技術
- 相容FOUP, SMIF以及SECS/GEM



## 表面缺陷宏觀檢測系統 Toho Stealth

- 可測量膜厚均勻性，微鏡鏡均勻性，及PSS高度均勻性，也可以測試尺寸較大的異物的刮傷等不良處
- 可採用紅，藍，及白光光源
- 支持SEMI 150~300mm晶圓，或LED 50~150mm圓片
- 最小可檢測顆粒大小28μm



## 太赫茲時域分析光譜儀/橢偏儀 Tera Evaluator

- 非接觸無傷載流子濃度與遷移率測試及電阻率測量
- 在太赫茲範圍內持續測試複雜的介質
- 可分析液體樣本
- 標配“太赫茲分析”軟體
- 可外置鐳射源



## PN檢測儀 Napson PN-12α/PN-50α/ PN-1S/PN-8LP

- 檢測PN極性
- 非接觸式檢測，不會造成表面損傷
- 測量範圍：  
PN-12α: 1mΩ·cm~20kΩ·cm(Bulk) 電阻係數  
PN-50α: 0.1Ω·cm~1kΩ·cm(Bulk) in Resistivity  
PN-1S: 0.01Ω·cm~1kΩ·cm(Bulk)  
PN-8LP: 0.02Ω·cm~5kΩ·cm(Bulk)
- LED顯示(P=Red, N=Green, NG=Yellow)



PN-50α



PN-8LP

### 手動四點探針測試儀

#### Napson RT-70V/RG-5/RG-7/RG-7S/RG-10

- 高精度測量ITO膜，金屬膜(RT-70V/RG-5/RG-7S)、納米銀絲
- 測試矽晶圓擴散層或金屬層的電阻係數及面電阻的電阻值 (RT-70V/RG-5/RG-7)
- 標準電阻測量精度優於±0.1% (0.01Ω~1MΩ)
- 重複性優於±0.2%(NIST標準片)
- 各種針粗與針壓可解決破片、隱裂、壓痕等問題
- 可用手持探頭作Ingot測量，也可用RG-10平臺自動測Ingot



### 半自動四點探針測試儀

#### Napson Cresbox

- 量測種類包括：Silicon Wafers、Diffused Wafers、Ion-implanted Wafers、Epitaxial Layers、Metal Films
- 具圖譜軟體功能，可作2D/3D圖形
- 具厚度/邊緣/溫度補償功能
- 全覆式暗箱測試遮罩周圍環境干擾
- 可通過電腦控制
- 內含溫度感測器
- 可量測尺寸：2"~8"Φ，晶圓或156mm電池片



### 半自動高精度四點探針測試儀

#### RT-3000/RG-2000(3000)

- 量測種類包括：Silicon Wafers、Diffused Wafers、Ion-implanted Wafers、Epitaxial Layers、Metal Films等
- 具圖譜軟體功能，可作2D/3D圖形
- 具厚度/邊緣/溫度補償功能
- 全覆式暗箱測試，遮罩周圍環境干擾
- 單機即可操作，亦可通過電腦控制
- 內含溫度感測器
- 可測量尺寸：2"~12"



### 非接觸式面電阻測試儀

#### Napson EC-80/EC-80P

##### EC-80 桌上型非接觸電阻率量測

- 適用晶圓2"~8"/300~800μm
- 量測種類包括：Silicon Wafers, GaAs Epi, GaN, GaP, ITO, Metal Layers
- 量程範圍：Low: 0.01~0.5Ω/□ High: 10~1,000Ω/□ Middle: 0.5~10Ω/□ S/High: 1,000~3,000Ω/□



##### EC-80P便攜型非接觸電阻率量測

- 量測種類包括：Silicon Wafers, GaAs Epi, GaN, GaP, ITO, Metal Layers, AgNW, Nx2O5, CNT
- 適用晶圓尺寸：2"~8"/300~800μm
- 可測量P/N極性
- 具溫度補償功能
- 多個量程探頭可選
- 標準測試台適用產品尺寸為2"~8"(尺寸亦可客制化設計)



### 非接觸式面電阻Mapping測試儀

#### Napson NC-80MAP

- 高精度面電阻測量，用於測量Silicon Wafer, GaAs EPI, GaN, GaP, InP, ITO, Metal Layers等
- 支持上限217點測量
- 軟體具2D、3D圖譜功能
- 距邊緣6mm亦可測量
- 可選擇NC-600MAP或NC-800MAP機種做為自動化晶圓分類系統



### 全自動四探針矽片分選系統

#### Napson WS-8800

- 四探針測試電阻率、非接觸測試厚度、PN極性
- 四探針自動分選、可根據需求定義測試點
- 3~8 inch、100~1000μm、1m~100K Ω·cm
- 測試裸矽片，半導體矽片等



### 高速全自動晶圓分選機

#### Napson NC-6800 + TTV

- 非接觸電阻率、PN、厚度(TTV、STIR、Bow、Warp等)測量
- 高穩定性，極低破片率
- 支持最大8"晶圓



### 全自動矽片分選系統

#### MicroSense UMA-C200L

- 可替代市場主流9600/9800分選機，產能提升30%
- 支持150mm及200mm矽片，2mm留邊
- 提供矽片厚度、Global Flatness、Site Flatness、Bow、Warp、SORI測量參數
- 選配電阻率及P/N判定
- 支持5個卡夾
- 整片掃描最多200,000點



### 矽片平坦度量測儀

#### Napson FLA300/FLA200

- 針對300mm半導體矽片平坦度量測，可相容200mm
- 測量厚度，TTV, Bow, Warp, Flatness等幾何參數，符合ASTM規範
- 可測量材料有矽，砷化鎵，鍺，磷化銦，碳化矽
- 2-D/3-D測量資料圖譜



### 半導體幾何參數及平坦度測量系統

- 電容法、APBP背氣壓技術、白光共焦技術、紅外光鐳射干涉技術

#### 測量參數

- 超薄晶圓的厚度、彎曲度及翹曲度
- 晶圓上膜層的應力
- Saw frame晶圓之各層厚度、總厚度、彎曲度及翹曲度
- 可呈現2D及3D的資料圖形



#### 適用晶圓及材料

- 3"~12"英寸半導體晶圓
- III-V族晶圓：GaAs、Ge、InP、GaN...
- 特殊晶圓：藍寶石Sapphire、石英Quartz、玻璃Glass、SiC、SOI矽片...
- Stacks of Wafers, Wafer on fame、Taped Wafer及Mounted Wafer
- 膜厚，TTV, Bow, Warp測試、Bending測試



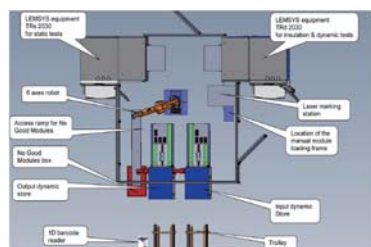
## 中大功率IGBT動靜態測試系統 LEMSYS TRd/TRs

- 應用於中大功率IGBT晶片/模組的動靜態測試
- 測試規範符合IEC60747, 高溫測試夾具, 系統寄生電感<75nH
- 動態測試: 1000A~8000A/1500V~4500V, 短路電流至14000A
- 靜態測試: 300A~10kA/1kV~10kV



## 中低功率IGBT動靜態測試系統 LEMSYS PRO AC/DC

- 應用於SiC/GaN/Si IGBT/MOSFET/Diode等功率半導體器件的動靜態測試
- 系統自身寄生電感<35nH
- 內置matrix切換矩陣可測試PIM複雜結構IGBT
- 可搭配高壓探針台實現IGBT晶圓等級靜態測試
- 動態測試: 600A/1500V, 短路電流至2500A
- 靜態測試: 200A~1800A/3kV~10kV



## 全自動動靜態測試方案 LEMSYS IGBT Automatic Test Line

- 針對產線大批量晶圓/晶片/子單元/模組的全自動測試線
- 相容自動進出料, 機械手抓取, 加熱製冷平臺, 鐳射達標等各項功能
- 可根據客戶要求搭配PRO AC/DC和TRds系列不同功率大小的動靜態測試主機
- 產能可達150~240顆/小時

## 雙面紫外光刻機 OAI 6000/800

- 雙顯微鏡CCD提高對準精度
- 線寬極致可達0.5μm
- UV光源自產, 更換便宜便捷
- 適合厚Wafer(6000μm)、大翹曲Wafer(7~10mm)
- 支持recipe storage
- 全球數百台裝機經驗, 應用包括: 半導體、MEMS、微流體、生物學、納米研究系統



## 實驗室級SiC IGBT動態特性測試儀 LEMSYS LAB-AC 0545

- 針對快速開關SiC器件的動態測試
- 測試項目包括di/dt, du/dt, Eon, Eoff, Err, Irr, Vth等
- 動態電流500A
- 動態電壓: 1.2kv, 1.7kv, 3.3kv, 4.5kv
- 室溫到200度加熱測試功能
- 極低系統寄生電感, 低至1ns開關測試速度



## 快速二極體動態特性測試系統 LEMSYS DMS

- 快速二極體開關性能測試, 如恢復測試, 開通測試
- 可通過電腦控制, 操作方便
- 模組化設計, 可方便實現不同測試要求
- 具有加熱測試的選項
- 測試電流範圍: 0.1~100A, 反轉電壓可達到1000V, 反向恢復時間(trr): 10nS~4μS



## 可攜式功率器件測試儀 LEMSYS TP0620

- 技術指標:
  - 崩潰電壓: 50~2000V
  - 漏電流: 0.1~10mA
  - 正嚮導通電壓跌落: 1~600A/0~10V
  - 門開極觸發脈衝: 1KV/200mA



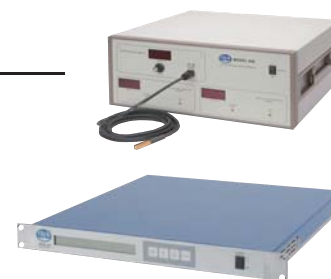
## 靜電吸盤供應器/優化器 TREK 640/645/646

### 經典應用

- 靜電驅動操作的材料
- 半導體制程中傳送晶圓
- 非機械平板顯示或材料的傳送

### 輸出相位

- 電壓A (參考相位): 0~±3 kV
- 電壓B (相位B=[-1] x相位A): 0~±3 kV
- 輸出電壓範圍: 0~±3 kV
- 輸出電流範圍: 0~±6.5 mA DC(峰峰值 10 mA)



## 35色全彩LED標準光源 GAMMA RS-7

- 適用於CCD/CMOS晶片, 攝像頭模組測試時提供標準全彩光源輸出
- 業界獨一無二的34色的LED光源集成一體, 模擬任意顏色輸出
- 75mm光斑輸出均勻性優於97%
- 波長範圍380~1000nm, 並可定制紅外/紫外波段輸出
- 提供NIST追溯標準光源校正報告
- 可特別定制夜視光源



## 手動分析型探針台

### 通用型手動探針台 Pegasus PG 101W

- 外觀緊湊，重量輕巧，高性价比
- 可選配不同探針、樣品測試平臺等選件，符合不同器件測試應用
- 適用於4"~8"晶圓測量
- 適合於科研/研發器件特性分析
- LED晶圓及晶片
- LD/PD等光電器件
- 分立器件/MEMS等半導體器件
- 其他複合功能材料/陶瓷材料/半導體材料特性分析



### 半自動探針台 Pegasus PG2000

- 針對LED、MEMS、DIODE等各類晶圓的8"半自動型探針台
- 相容各種LED、DIODE、MEMS的主流測試機，實現自動mapping測試
- CCD掃描功能，上片自動對位測試
- 相容各類探針卡，支持變溫chuck
- 可搭配積分球，光源系統等各類定制需求
- 中文作業系統，軟體相容性佳



### 半自動雙面探針台 Pegasus 2000D

- 落地一體式緊密設計，體積輕巧
- 高精度馬達驅動，穩定安靜的運行環境
- 雙面探針結構，改善測試回路阻抗問題
- 可點測3"~8"晶片
- 測試電流可達30A
- 提供TTL、RS232等通訊方式，輕易搭配各廠牌測試機
- 夾片盤尺寸自動偵測，可防止撞針意外



### 全自動雙面探針台 Pegasus FAPG150D

- 針對功率型DIODE/MOSFET晶圓的專業雙面測試探針台
- 相容2"~6"晶圓測試
- 提供半自動人工上片和全自動cassette自動上片方式
- CCD自動對位，mapping測試
- 上下探針測量方式，消除chuck上多餘阻抗
- 支持30A以上電流測試
- 提供鎢鋼，鉍銅，合金，彈簧針等各種探針方案
- 極佳的針痕控制，自動量測上下探針的彈簧力度



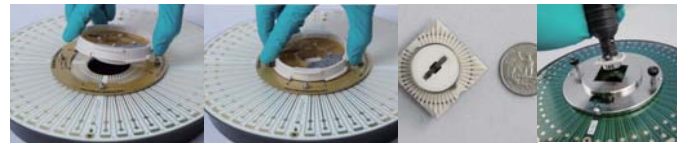
### FA實驗分析探針台 Wentworth S200FA/300FA

- 針對8"~12"晶圓以下FA分析IC Debug
- 可搭配-65°C~300°C溫控平臺
- 可搭配RF探頭及fA級微電流探針
- 載入500x~2000x高倍顯微鏡
- 選配遮罩罩及防震台
- 根據不同類型測試儀器，選配相應Cable及Connector
- 可整合尖端的鐳射切割系統及CCD影像系統
- 程式控制探針座設計，Labmaster專用操作軟體



### 手動/半自動高壓大電流探針台 Wentworth M200FA/S200FA-HV

- 針對大功率IGBT、MOSFET晶圓/晶片測試
- 可耐10kV高壓測試，200A脈衝電流，遮罩安全保護
- Kelvin式絕緣chuck設計，高壓大電流測試針座及連接線
- 可定制高壓/大電流探針卡或氮氣探針卡
- 可選用乾燥空氣或氮氣降低露點，防止高壓火花放電
- 支援Inker功能
- 可通過TTL，RS232，GBIP搭配各類IGBT測試機

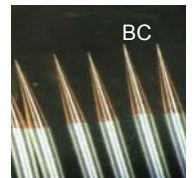


### CELADON單點/多點探針卡 VC20E/TC40

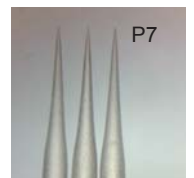
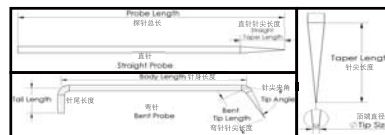
- 在WAT, RE, Modeling, TD等部門，輔助晶圓探針測試
- 低漏電流，電容穩定性好，耐損耗
- 主要規格：漏電流<5fA，適用溫度範圍-65°C~300°C
- 應用：用於半導體行業，連接晶圓及探針台，評估晶圓品質

### 專業LED探針 APS P7/BC

- 美國APS正品探針，用於LED晶片點測
- HBC 硬鍍銅探針，導電性最佳
- P7合金，超高壽命，兼顧良好的導電性
- 針尖規格從5μm~20μm可定制，直針彎針可選
- 廣泛應用於目前LED行業的晶片點測，可搭配各類型探針台設備



#### 標準規格如下圖





### 平板顯示行業阻抗測試儀 Napson RT-3000/RS-1300

- 利用四點探針方式對TFT-LCD/CF之Substrates(ITO、Metal Layers及n+a-Si Layers)進行大面積、高精度、高穩定的全自動量測
- 可加裝高阻，膜厚，穿透率，接觸角等功能
- 方阻量測範圍為1mΩ/sq~1GΩ/sq，已成功設計生產G10.5，可容納2880X3080mm的玻璃機台，也可根據客戶要求進行定制
- TFT/LCD, CF, OLED, TP, IZGO, LTPS etc.

NC-600



NC-700

### 非接觸式電阻率測試模組 Napson NC-600/NC-700

- 利用渦電流非接觸式的原理線上測試玻璃表面導電薄膜的阻抗進行產線品質監控
- 可根據客戶的要求進行定制設計，可增加穿透率測試功能
- 測量範圍：0.001~2000 ohm/sq

### 掌上型二合一電阻測試儀 Napson DUORES

- 掌上型電阻測試儀
- 具備四探針和渦電流兩種探頭可進行切換
- 測量範圍：0.5~50 Ω/sq(渦電流法)  
0.1~1000 Ω/sq (四探針法)



### AR/VR近眼顯示測試系統 GAMMA NED GS-1290 NED

- 獨特模擬模擬頭盔式設計，模擬1mm~5mm人眼瞳孔收光手動及自動定位測量模式
- 測量顏色亮度均勻性，回應時間，左右眼視差，MTF測試，虛像距離
- 可實現自動對位校準，並模擬外部環境光



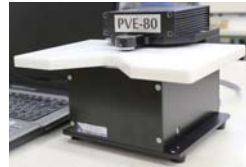
### 6軸機器人全自動LCD測試系統 GAMMA GS-940-7X

- 搭配GS系列光譜儀實現全自動全角度顯示幕測試
- 測量視角、對比度、均勻度、色溫、亮度、回應時間等
- 支持3D及曲面LCD測量
- 自帶MFT測量模組和LCD驅動程式



### 液晶阻值測量系統 Quatek RST-100

- 可應用於液晶材料之進料檢驗
- 系統由高精度高阻測量儀、標準化治具組成，只需設定液晶電阻測量之基本參數即可測量
- 治具本身經特殊處理，可隔離接線的雜訊及環境的干擾
- 液晶測量範圍可達1015Ω·cm以上
- 具有通過二級實驗室校驗之標準電阻可供機台校驗使用：1GΩ，500GΩ，1TΩ，5TΩ，50TΩ



### 非接觸高精度超低阻測試儀 Napson PVE-80

- 非接觸脈衝電壓激勵法實現非破壞性測量
- 量程範圍50μ~1m ohm/sq
- 測量及移動方便，測量平臺可裝卸
- 電腦軟體控制測量及資料處理
- 測量資料可顯示3種單位(面電阻值[Ohm/Sq]，電導率[S/cm]，電導值[S])
- 脈衝電壓激勵法：專利號5386394

### 非接觸式超高量程 面電阻測量系統 Napson CRN-100

- 非接觸式超高面電阻測量109~1015 ohm/sq
- 可程式設計測試點位元軟體：- 可程式設計多點測試 - 2D和3D測試資料圖譜
- 基於Windows7的測試軟體
- 測試資料可匯出.CSV格式
- 測量不受接觸電阻影響
- 運用電量放電的測試原理



### 光譜反射橢偏儀 SCI FilmTek™ 2000SE

- 臺式計量系統提供了無與倫比的測量性能
- 適合科研和研發應用
- 結合了光譜橢偏法和DUV多角度偏振反射法
- 可同時測量薄膜厚度，折射率和消光係數



### 薄膜應力測量系統 MicroSense UMS-C200

- 與市場主流5400/5500系統測量資料一致
- 支持6、8 inch晶圓，2mm留邊
- 支持Open Casstte, SMIF
- 整片掃描超過120,000點
- 精確的曲率半徑計算
- 可支援半自動及全自動機型



### 反射率/透射率測量系統 GAMMA 191系列

- 獨特的光路設計，達到測量AR層上表面反射率
- 從380nm~1700nm波長反射測量(使用191Q是從200nm~2000nm)
- 可選固定角度和多角度不同種型號
- 可測試玻璃的漫反射率和鏡面反射率
- 光纖耦合測量設備，操作方便
- 使用石英鹵素光源或LED光源



### 光功率計/輻射度計 UDTi S470/480/490

- 測量包括lm, mW/cm2, cd, j/m2, lux等10種不同亮度輻射度單位
- 各種亮度探頭可選，波長範圍200~1750nm
- CIE視效函數濾片可供選擇f1<0.8%
- 可支援4組探頭連接測試







### 半自動四探針測試系統 Napson RG-200PV

- 太陽能電池片、薄膜電池片半自動四探針設備
- 每片平均掃描或者隨機掃描最多1000點
- 矽片/玻璃襯底尺寸：最大為160x160mm
- 2D/3D方塊圖形軟體(選件)
- 面電阻：1mΩ/□~1000kΩ/□
- (選件：1mΩ/□~10MΩ/□)
- 電阻率：1mΩ·cm~200Ω·cm
- 測試較快，15秒測試5點



### 高速多探頭電阻測試儀 Napson DF-9P

- 測試樣品：太陽能擴散片
- 測試方式：4點探針法
- 測試範圍：0.001~1000Ω/sq
- 測試點：9點同時測試
- 可選配Mapping功能

### 線上非接觸式光壓法方阻測量模組 Napson JPV-100

- 量程範圍10~200ohm/sq
- 運用光壓法原理進行擴散方阻量測
- 可與各類型自動化設備進行搭配使用，實現線上測量



### 太陽能電池片反射率測量儀 SCI FilmTek IS

- 寬達10.3mm的光照孔，內置積分球提供180°的均勻照度，可全光反射率測試
- 內置切換開關，可測試漫反射和鏡面反射率
- 搭配FilmTek系統使用，可測試粗化太陽能電池



可配合探針台PG2000  
实现半自动点测



### GaAs聚焦太陽能電池/ 多結太陽能電池測試系統 SW Link RPV系列

- 量測多結太陽能電池的串聯電阻RS，隧道結峰值IP和峰穀電流IV，量子效率和能量轉換效率
- 只需單個光脈衝，最高照度>10,000倍太陽光強
- 量測串聯電阻RS與光電流的函數關係
- 最大短路電流100安培，最高開路電壓6伏
- 適用於1x1mm2到15x15mm2CPV太陽能電池

### 線上四探針方阻測量模組 Napson DF-100

- 量程範圍0.01~1000ohm/sq
- 同時進行9點量測，測試時間小於10秒
- 9點探頭位置可根據客戶需求進行定制
- 可與各類型自動化設備進行搭配使用，實現線上量測



### 非接觸式電阻率測試模組 Napson NC-100PV

- 模組式線上矽片電阻測試設備
- 可增加P/N,厚度,TTV測試模組
- 電阻率 0.1~15Ω·cm 厚度 100~1000µm



### 薄膜綜合參數測試系統 SCI FilmTek Solar

- 可同時測試並得到薄膜厚度，反射率，折射率，消光係數等參數
- 寬達25°收光角度，直接測試絨面
- 大範圍厚度測試能力，3nm~150µm
- 單點測試速度快，僅需不到1s時間



### 太陽光模擬器 OAI PV& I-V System



#### 太陽光模擬器

- AAA級認證
- 占地小
- 持續波形&SLP
- 光線覆蓋達208mm
- 長距離工作範圍

#### I-V 測試

- 可設置參數
- 軟體腳本控制
- 自校準功能設計
- 資料庫整合
- 溫控測試平臺

### 非接觸式少子壽命 (Life-Time)測試儀 Napson HF-300

- 微波光電導衰減法(μ-PCD)
- 非接觸式少子壽命測量
- 測量範圍：0.1µS~1000µS  
(0.1~1000Ω·cm範圍內)
- 可根據客戶要求，提供線上式和離線式機台



### 全自動電化學C-V Profiler測試系統 Nanometrics ECVPro

- 可作半導體材料及外延層材料縱向摻雜濃度分佈測試
- 應用材料：III-V族、GaAs、GaN、II-VI族、Si及寬頻半導體材料
- 高效率全自動，包含Cell Fill/De-bubble/Cell Empty/Sample Clean，提高測量重複性與精確性
- 可做Whole Wafer測量，並可多點測量
- 採用非汞電極，符合RoHs規範



QUATEK<sup>int'l. Ltd.</sup>

德技先進有限公司台灣分公司

(台北)台北市內湖區內湖路一段308號4樓

郵編：11493

電話：+886-2-27973357

傳真：+886-2-27973957

(新竹)新竹縣竹北市嘉豐六路一段96號2樓

郵編：30271

電話：+886-3-6577776

傳真：+886-3-6577779

(高雄)高雄市三民區大順二路60號3樓之1

郵編：80787

電話：+886-7-3855821

傳真：+886-3-6577779

<http://www.quatek.com.tw>

E-mail:sales@quatek.com.tw

QUATEK<sup>Inc. SH</sup>  
德儀国际贸易(上海)有限公司

(上海)上海市中山西路2025號永升大廈2112室

郵編：200235

電話：+86-21-64813366

傳真：+86-21-64813369

(北京)北京市朝陽區紅軍營南路15號院瑞普大廈C座506

郵編：100012

電話：+86-10-82250468

傳真：+86-10-82250814

(深圳)深圳市寶安區13區寶通大廈2509室

郵編：518133

電話：+86-755-33815218

傳真：+86-755-33815099

(西安)西安市高新區唐延南路逸翠園i都會3號樓1單元528室

郵編：710065

電話：+86-29-88825124

(成都)成都市高新區吉泰五路88號香年廣場T2-2510室

郵編：610061

電話：+86-28-86286355

(廈門)廈門市湖裡區高林村田裡社47號

郵編：361009

電話：+86-592-5323890

(合肥)合肥市瑤海區勝利路鐵路琅琊社區18棟408室

郵編：241008

電話：+86-13514913729

(南昌)南昌市青山湖區順外路錦湖花園3棟1單元803室

郵編：330029

電話：+86-18970998127

(蕪湖)蕪湖市鳩江區經濟技術開發區玫瑰園3-2-803室

郵編：241008

電話：+86-18055383285

<http://www.quatek.com.cn>

E-mail:sales@quatek.com.cn



V7.0T 2018.04

QUATEK

[sales@quatek.com.tw](mailto:sales@quatek.com.tw)